

	<p>SI7860DP-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7860DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7860DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 154794 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7860DP-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	154794 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)






















SI7860DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7860DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7860DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7860DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7862ADP-T1-E3 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 16V 18A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7860ADP-T1-E3 VISHAY SI7860ADP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7860DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7860DP-T1-GE3 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7860DP VISHAY SI7860DP VISHAY</p>	 <p>SI7862ADP SI SI7862ADP SI</p>	 <p>SI7860DP-T1 VISHAY SI7860DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7860DP-T1-E3 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI7852DP-T1-GE3 |  SI7856ADP |  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-GE3 |
|  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1 |  SI7856DP-T1-GE3 |  SI7856DP-TI-E3 |  SI7858ADP |
|  SI7858ADP-T1-E3 |  SI7858ADP-T1-E3 |  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858BDP |
|  SI7858BDP-T1-E3 |  SI7860ADP |  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860ADP-T1-GE3 |
|  SI7860ADP-T1-GE3 |  SI7860ADP-TI-E3 |  SI7860DP |  SI7860DP-T1 |  SI7860DP-T1-E3 |
|  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-TI-E3 |  SI7862ADP |  SI7862ADP-T1-E3 |
|  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862DP |  SI7862DP-T1 |
|  SI7864ADP |  SI7864ADP-T1-GE3 |  SI7864DP-T1-GE3 |  SI7866ADP |  SI7866ADP-T1-E3 |
|  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |  SI7866DP-T1 |  SI7866DP-T1-E3 |
|  SI7866DP-T1-GE3 |  SI7868ADP |  SI7868ADP-T1-E3 |  SI7868ADP-T1-E3 |  SI7868ADP-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited